

2SA603

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ / PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

高周波増幅、中速度スイッチング用 /

High Frequency Amplifier, Medium Speed Switching

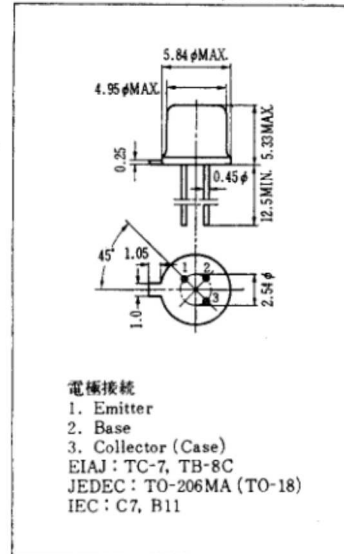
通信工業用 / Industrial Use

特 徴 / FEATURES

- ・電源電圧の変動に対して余裕があります。V_{CEO} : -40V
Keeps stabilized operation against power voltage fluctuation.
- ・従来の拡散形トランジスタに比べてベース逆バイアスを深くかけることができます。
V_{EBO} : -8.0V
Available for deeper base reverse bias than with normal diffused transistor.
- ・高周波増幅はもとよりスイッチング、低周波増幅などの用途にも適します。
Suitable for switching and audio amplifiers as well as high frequency amplifiers.

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a = 25°C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	-8.0	V
コレクタ電流	I _C	-200	mA
全損失	P _T	300	mW
ジャンクション温度	T _J	150	°C
保存温度	T _{stg}	-65 ~ +150	°C

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a = 25°C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CE} = -40V, I _E = 0			-0.5	μA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = -5.0V, I _C = 0			-0.5	μA
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} = -1.0V, I _C = -10mA	80	140	240	
直流電流増幅率	h _{FE2}	V _{CE} = -1.0V, I _C = -100mA	30	70		
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -100mA, I _E = -10mA		-0.25	-0.7	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C = -100mA, I _B = -10mA		-0.85	-1.20	V
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} = -10V, I _E = 10mA	150	250		MHz
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} = -10V, I _E = 0, f = 1.0MHz		7.5	10	pF
ターンオン時間	t _{on}			150		ns
蓄積時間	t _{stg}	測定回路図参照/See test circuit		240		ns
ターンオフ時間	t _{off}			300		ns

h_{FE} 区分 / h_{FE} Classificationh_{FE1} / 80~130 110~170 150~240